

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **55143754 A**

(43) Date of publication of application: 10 . 11 . 80

(51) Int. Cl.

H01J 11/02

(21) Application number: **54051909**

(22) Date of filing: 25 . 04 . 79

(71) Applicant: **FUJITSU LTD**

(72) Inventor: **OTSUKA AKIRA
SHIROUCHI YASUNARI**

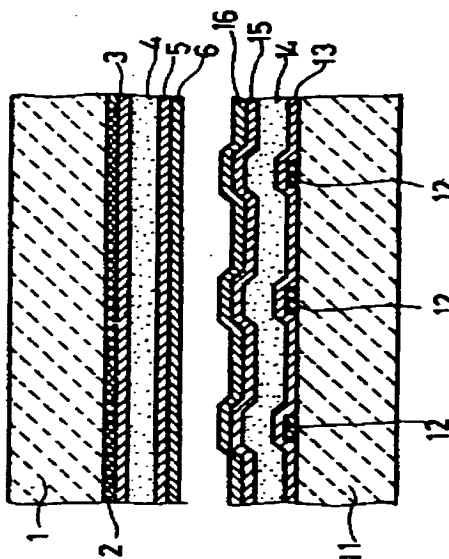
(54) **GAS DISCHARGE PANEL**

COPYRIGHT: (C)1980,JPO&Japio

(57) Abstract:

PURPOSE: To form a high quality dielectric layer efficiently in short time, by sequentially laminating first layer of Al_2O_3 , second layer of glass containing specific amount of SiO_2 and third layer of Al_2O_3 on an electrode.

CONSTITUTION: A plurality of X electrodes 2 and Y electrodes 12 of Cr-Cu are formed on each surface of glass substrates 1, 11. Preferably $3,000W10,000\text{\AA}$; depth of first layers 3, 13 of Al_2O_3 are formed through vacuum deposition on the electrode of said substrate, then second layers 4, 14 of high silicate glass containing at least 80% of SiO_2 are coated with the depth of $2W10\mu m$, while furthermore third layers 5, 15 composed of same Al_2O_3 with that of the first layer are coated with the depth of $3,000W10,000\text{\AA}$. Moreover surface layers 6, 16 of MgO having excellent discharge characteristic are formed through vacuum deposition or sputtering. Consequently high quality dielectric layer can be formed efficiently in short time.



⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑫ 公開特許公報 (A)

⑪ 特許出願公開

昭55-143754

⑬ Int. Cl.³
H 01 J 11/02

識別記号

庁内整理番号
7520-5C

⑭ 公開 昭和55年(1980)11月10日

発明の数 1
審査請求 有

⑮ ガス放電パネル

(全 3 頁)

⑯ 特 願 昭54-51909
⑰ 出 願 昭54(1979)4月25日
⑱ 発 明 者 大塚晃
川崎市中原区上小田中1015番地
富士通株式会社内

⑲ 発 明 者 城内康成
川崎市中原区上小田中1015番地
富士通株式会社内
⑳ 出 願 人 富士通株式会社
川崎市中原区上小田中1015番地
㉑ 代 理 人 弁理士 井桁貞一

明 細 書

1. 発明の名称

ガス放電パネル

2. 特許請求の範囲

(1) 誘電体層で被覆された電極を形成してなる1対の基板を、ガス放電空間を介して対向配置した構成を有するガス放電パネルにおいて、前記誘電体層が、電極上に直接被覆したA12O₃からなる第1層と、SiO₂を80%以上含むガラスからなる第2層、およびA12O₃からなる第3層を順に積層形成した多層膜構造を有してなることを特徴とするガス放電パネル。

(2) 前記8層膜構造の誘電体層上に酸化マグネシウムの被膜を形成してなることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載のガス放電パネル。

(3) 前記多層膜誘電体層を構成する第1および第8のA12O₃層が、8000~10000Åの厚みを有し、第2のSiO₂を80%以上含むガラス層が2~10μmの厚みを有することを特徴とする特許請求の範囲第1項または第2項に

記載のガス放電パネル。

3. 発明の詳細な説明

本発明はガス放電パネルの改良に関し、特に該パネルの電極上に設けられる誘電体層の改良に関するものである。

プラズマ・ディスプレイ・パネルの名称で知られるAC駆動型のガス放電パネルは、ドット表示形式のマトリックス型を始め、特殊な電極パターンを採用した数字表示用のパネルあるいはセルフシフト型のパネル等種々のタイプが提案されている。しかし従来この種ガス放電パネルにあつては、基板上に形成された電極をガス放電空間から絶縁するための誘電体層として低融点ガラス等の融着層を用いるのが通例であつた。ところがこの低融点ガラスよりなる誘電体層は印刷法などによつて塗布し、焼成して形成されるものであるから、層内に気泡が残つたり、厚みが部分的に不均一となる等の欠点があり、パネルの高密着、高品質表示を困難とし、さらには、パネルの大型化が阻害されていた。このため、最近のパネルでは、

たとえば電子ビーム蒸着法 を駆使した薄膜技術 によつて膜質の改良された均一性の良い薄膜誘電 体層を用いることが試みられている。

すなわちこの薄膜技術によるパネルでは、た とえばCrとCuの薄膜を2重に積層してなる電極 を形成したガラス基板上にアルミナ(Al_2O_3)を 真空蒸着法等によつて被着し、さらにその上面に 放電特性の優れた酸化マグネシウム(MgO)から なる表面層を、同じく真空蒸着法あるいはスパツ ク法等によつて被着して誘電体層としたものが提 案されている。

しかしながら上記アルミナ(Al_2O_3)によつて 形成される誘電体層の膜厚は、その部材の誘電率 との関係からたとえば $4\sim 20\mu m$ 程度と厚い膜 を必要としており、これがために膜形成に長時間 を要すると共に、その膜厚が $10\mu m$ 以上に及ぶ と、その後の熱処理工程、たとえばパネルの封止 工程においてその膜面にクラックが生じやすい欠 点があつた。またこの長時間蒸着によつて、蒸着 中に蒸着チャンバ内の保持具類に被着した蒸着物

8

上のような状況から高品質の誘電体層を短時間で 効率よく形成することを目的とするもので、誘電 体で被覆された電極を形成してなる1対の高板を、 ガス放電空間を介して対向配置した構成を有する ガス放電パネルにおいて、前記誘電体層を、電極 上に直接被着した Al_2O_3 からなる第1層と SiO_2 を80%以上含むガラスからなる第2層および Al_2O_3 からなる第3層を取に積層形成した多層 膜構造とした点に特徴を有するものである。

以下本発明の好ましい一実施例につき図面を参 照して詳細に説明する。図は本発明の一実施例を 説明するためのパネル構成基板の要部断面図であ る。

図において1及び11はガラス基板であり、そ の各一表面には、たとえばクロム-銅(Cr-Cu) 等の多層構造からなる複数のX電極2及びY電極 12が形成されている。誘電板2または12を形 成せる基板1、11上に誘電体層を構成するには、 まずその蒸着速度が従来のアルミナ(Al_2O_3)よ り2倍以上大きく、誘電体層の主体となる SiO_2

6

特開昭55-143754(2) が剥離落下しやすくなり、これに起因して誘電体 層を汚損し、放電 性にバラツキを与える問題が あつた。そこで誘電体層の部材として、その蒸着 速度が従来のアルミナ(Al_2O_3)よりも2倍以上 大きく、しかも形成された膜質は従来のものと通 色のない SiO_2 を80%以上含む高純度ガラスを 用いることが考えられるが、この場合前記高純度 ガラスは、その熱膨張係数($4\sim 80\times 10^{-7}/^{\circ}C$) が前記ガラス基板の熱膨張係数(約 $80\times 10^{-7}/^{\circ}C$) よりも非常に小さいため、この高純度ガラス を直接前記基板上に形成すれば、その後の熱処理 によつてクラックが発生することは明らかである。 したがつて本発明は上記 SiO_2 を80%以上含む 高純度ガラスを主要部とした誘電体層の実現を図 るべく、前記ガラス基板と高純度ガラスの中間の 熱膨張係数($50\sim 80\times 10^{-7}/^{\circ}C$)を有する Al_2O_3 で前記高純度ガラスをサンドイッチ状に挟ん だ構造を提案し、もつてクラック発生のない高品 質の誘電体層を得ようとするものである。

すなわちさらに具体的に述べると、本発明は以

4

を80%以上含む高純度ガラス(以下高純度ガラ スと呼ぶ)層を形成するに先だち、アルミナ(Al_2O_3)からなる第1層8、18を、好ましくは $8000\sim 10000\text{\AA}$ の厚みに真空蒸着法等によ つて形成する。引き続きその上面に前記高純度ガ ラスからなる第2層4、14を $2\sim 10\mu m$ の厚 みに被着形成し、さらに続いて第1層8、18と 同質のアルミナ(Al_2O_3)からなる第3層5、15 を $8000\sim 10000\text{\AA}$ の厚みに被着形成する。 引続いてその層上に $2000\sim 10000\text{\AA}$ の厚さ に、放電特性が優れた酸化マグネシウム(MgO) 等のIIA族元素の表面層6、16を同じく真空蒸 着法またはスパツク法によつて形成した構成とす る。

このように構成した誘電体層は、その主材とす る高純度ガラスからなる第2層4、14が、基板 1、11との間にアルミナ(Al_2O_3)からなる第 1層8、18の $8000\sim 10000\text{\AA}$ の膜厚を介 在させて形成しているため、各熱膨張係数の差が 緩和され、前記第2層4、14を $10\mu m$ 程度と

6

厚く形成してもクラックが生じることがない。また表面層に形成する MgO （熱膨張係数、約 $8.6 \times 10^{-7}/^\circ\text{C}$ ）層6、16についても、前記阿諾高硫酸ガラスと MgO との中間の熱膨張係数を有する Al_2O_3 を介在させることによつて、前記 MgO 層6、16にクラックが発生する問題を解消するものである。以上のように誘電体層を多層構造とすることで、その種の熱処理工程においてクラックが発生することなく、しかも主材とする前記高硫酸ガラスの蒸着速度が大きいので、このようにクラックの誘電層としてアルミナ層を介在させる構造としても従来に比べ、短時間で効率よく高品質の誘電体層を形成することが可能となる。

以上の説明から明らかなように、本発明によれば、ガス放電パネルを構成する誘電体層に、その蒸板と熱膨張係数の差を持つ SiO_2 を80%以上含む高硫酸ガラスを用いることが可能となり、その蒸着速度が大きいこと、またその誘電率が小さいこととあいまつて従来より誘電体膜厚を薄く構成できること等から、クラック発生がなく、高品質

特願昭55-143754(3)

質で安定な誘電体層を短時間で効率よく形成することができ、製造工数の低減、歩留り向上が可能となるなど実用上の効果は大きい。

4. 図面の簡単な説明

図は本発明の一実施例を説明するためのパネル構成基板の要部断面図である。

1、11：蒸板、2、12：電極、3、13： Al_2O_3 からなる第1層、4、14： SiO_2 を80%以上含む高硫酸ガラスからなる第2層、5、15： Al_2O_3 からなる第3層、6、16：酸化物質層。

代理人 弁理士 井 村 貞 一

図 面

